異方性磁気抵抗 (AMR) 効果の直感的説明と ハーフメタリック強磁性体の必要条件「負のAMR」

Intuitive Explanation of Anisotropic Magnetoresistance (AMR) Effect and Necessary Condition for Half-Metallic Ferromagnet "Negative AMR"

静大工¹,東北大工² ○古門聡士¹,北川佑太¹,角田匡清²

Shizuoka Univ.¹, Tohoku Univ.² Satoshi Kokado¹, Yuta Kitagawa¹, Masakiyo Tsunoda² E-mail: tskokad@ipc.shizuoka.ac.jp

強磁性体の異方性磁気抵抗 (AMR) 効果 [電気抵抗が磁化 (M) 方向に依存] は,磁性と伝導性が絡む最も基礎的な現象の 1 つである.その効果の効率を表す AMR 比は $(\rho_{//}-\rho_{\perp})/\rho_{\perp}$ で表される.ただし, $\rho_{//}$ は電流 (I)//M のときの抵抗率, ρ_{\perp} は I \perp M のときの抵抗率である.AMR 効果は約 150 年前から現在まで種々の強磁性体に対して調べられてきたが,AMR 効果の直感的説明はほとんど行われてこなかった.そこで本研究では,AMR 比の一般式を導出した上で,種々の強磁性体の AMR 効果に対して直感的説明を与えた [1].さらにハーフメタリック強磁性体が必ず負の AMR 比を示すことも見出した.詳細は以下のとおりである.

AMR 効果に大きな影響を与える抵抗率は s-d 散乱による抵抗率 (s-d 抵抗率) である.これはスピン偏極伝導電子 (s 電子) が不純物により局在 d 軌道へ散乱される場合の抵抗率である.ここで,局在 d 軌道は交換分裂エネルギーとスピン軌道相互作用 V_{SO} を持つ模型から得られる.得られた d 軌道は, $V_{SO}=0$ の系の軌道と比べて M 方向に歪んだ形になった.例えば↑スピンの d 軌道に注目するとき,↑スピンの軌道 (支配的成分) は M 方向に縮み,僅かに混じってきた↓スピンの軌道 (混成成分) は M 方向に伸びた形になった.電子雲の概略図 (Fig. 1) では,支配的成分は M 方向を 短軸とする大きな楕円,混成成分は M 方向を長軸とする小さな楕円で表された.

この d 軌道の形状を考慮に入れることで AMR 効果は説明され得る.特に「(i) V_{SO} により M 方 向//軌道z方向である」と「(ii) s-d 抵抗率はフェ ルミ準位上の局在 d 軌道 (電子雲) の I 方向の大き さに依存する」の2点を用いる.例えば↑スピン 側が金属的なハーフメタリック強磁性体を考える (Fig. 2) . ↑ スピンの電子雲は , M 方向を短軸とす る楕円で表される.Mを回転させるとき,電子雲 (楕円) は(i) より M とともに回転する. I 方向を 固定した上で M を回転させるときは,電子雲(楕 円)の1方向の大きさが変化することになる.従っ て, (ii) より s-d 抵抗率は M 方向に依存する. な おこの系では,電子雲のI方向の大きさを反映し て, $I \perp M$ の s-d 抵抗率が I//M のそれより大き くなる. 結果として, 負の AMR 比が得られる. 講演では, Ni 等で観測される正の AMR 比につ いても説明する.

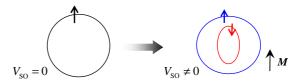


Fig. 1: Electron cloud of the localized d orbital. When the electron cloud of $V_{SO}=0$ is expressed as a circle (left panel), that of $V_{SO} \neq 0$ becomes an ellipse (right panel). An arrow $\uparrow (\downarrow)$ denotes \uparrow spin (\downarrow spin).

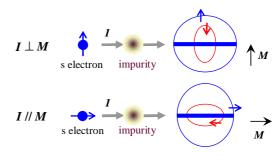


Fig. 2: s-d scattering of \uparrow spin electron. Upper panel: $I \perp M$. Lower panel: I//M. The length of a bar in each localized d orbital represents the magnitude of the electron cloud of the I direction.

[1] S. Kokado, M. Tsunoda, K. Harigaya, and A. Sakuma, J. Phys. Soc. Jpn. **81** 024705 (2012); S. Kokado and M. Tsunoda, Adv. Mater. Res. **750-752** 978 (2013), Phys. Status Solidi C **11** 1026 (2014).